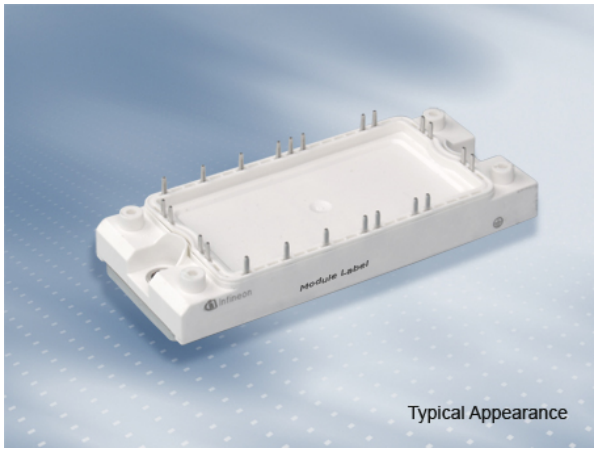
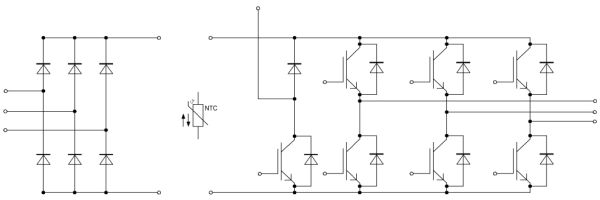
EconoPIM™2 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
EconoPIM™2 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 3 diode and NTC





V_{CES} = 650V
$I_{C\ nom}$ = 75A / I_{CRM} = 150A

Typische Anwendungen
- Motorantriebe

Typical Applications
- Motor drives

Elektrische Eigenschaften
- Erhöhte Sperrspannungsfestigkeit auf 650V
- Hohe Kurzschlussrobustheit
- $T_{vj\ op}$ = 150°C
- Trench IGBT 4
- V_{CEsat} mit positivem Temperaturkoeffizienten

Electrical Features
- Increased blocking voltage capability up to 650V
- High short-circuit capability
- $T_{vj\ op}$ = 150°C
- Trench IGBT 4
- V_{CEsat} with positive temperature coefficient

Mechanische Eigenschaften
- Integrierter NTC Temperatur Sensor
- Isolierte Bodenplatte
- Kupferbodenplatte
- Lötverbindungstechnik

Mechanical Features
- Integrated NTC temperature sensor
- Isolated base plate
- Copper base plate
- Solder contact technology

Module Label Code

Barcode Code 128

Sample
00000123456000000000000

DMX - Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

IGBT,Wechselrichter / IGBT,Inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	T_{vj} = 25°C	V_{CES}	650	V
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	T_C = 70°C, $T_{vj\,max}$ = 175°C T_C = 25°C, $T_{vj\,max}$ = 175°C	$I_{C\,nom}$ I_C	75 95	A A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	t_P = 1 ms	I_{CRM}	150	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	I_C = 75 A, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 25°C I_C = 75 A, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 125°C I_C = 75 A, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 150°C	$V_{CE\,sat}$		1,55 1,70 1,75	1,95	V V V
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	I_C = 1,20 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C	V_{GEth}	5,05	5,80	6,45	V
Gateladung Gate charge	V_{GE} = -15 V ... +15 V	Q_G		0,75		µC
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	T_{vj} = 25°C	R_{Gint}		0,0		Ω
Eingangskapazität Input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V	C_{ies}		4,60		nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V	C_{res}		0,145		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 650 V, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C	I_{CES}			1,0	mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25°C	I_{GES}			100	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	I_C = 75 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 5,1 Ω, T_{vj} = 150°C	$t_{d\,on}$		0,025 0,025 0,025		µs µs µs
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	I_C = 75 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 5,1 Ω, T_{vj} = 150°C	t_r		0,02 0,02 0,02		µs µs µs
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	I_C = 75 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 5,1 Ω, T_{vj} = 150°C	$t_{d\,off}$		0,21 0,24 0,25		µs µs µs
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	I_C = 75 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 5,1 Ω, T_{vj} = 150°C	t_f		0,06 0,07 0,07		µs µs µs
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	I_C = 75 A, V_{CE} = 300 V, L_S = 30 nH, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, di/dt = 4000 A/µs (T_{vj} = 150°C), T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 5,1 Ω, T_{vj} = 150°C	E_{on}		0,385 0,55 0,66		mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	I_C = 75 A, V_{CE} = 300 V, L_S = 30 nH, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, du/dt = 4000 V/µs (T_{vj} = 150°C), T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 5,1 Ω, T_{vj} = 150°C	E_{off}		3,35 3,90 4,20		mJ mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 360 V, t_P ≤ 10 µs, T_{vj} = 25°C V_{CEmax} = V_{CES} -L_{sCE} ·di/dt, t_P ≤ 10 µs, T_{vj} = 150°C	I_{SC}		360 290		A A
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro IGBT / per IGBT	R_{thJC}			0,600	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,327		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions		$T_{vj\,op}$	-40		150	°C

Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}		650	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_F		75	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	t_P = 1 ms	I_{FRM}		150	A
Grenzlastintegral I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 150°C	I²t		660 610	A²s A²s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	I_F = 75 A, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C I_F = 75 A, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 125°C I_F = 75 A, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 150°C	V_F		1,55 1,50 1,45	1,95	V V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	I_F = 75 A, - di_F/dt = 4000 A/µs (T_{vj}=150°C), T_{vj} = 25°C V_R = 300 V, T_{vj} = 125°C V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 150°C	I_{RM}		100 115 125		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	I_F = 75 A, - di_F/dt = 4000 A/µs (T_{vj}=150°C), T_{vj} = 25°C V_R = 300 V, T_{vj} = 125°C V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 150°C	Q_r		3,00 6,00 7,50		µC µC µC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	I_F = 75 A, - di_F/dt = 4000 A/µs (T_{vj}=150°C), T_{vj} = 25°C V_R = 300 V, T_{vj} = 125°C V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 150°C	E_{rec}		0,95 1,50 1,85		mJ mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode	R_{thJC}			0,950	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,517		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions		$T_{vj\,op}$	-40		150	°C

Diode, Gleichrichter / Diode, Rectifier

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}		1600	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip Maximum RMS forward current per chip	T_C = 80°C	I_{FRMSM}		80	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom Maximum RMS current at rectifier output	T_C = 80°C	I_{RMSM}		100	A
Stoßstrom Grenzwert Surge forward current	t_p = 10 ms, T_{vj} = 25°C t_p = 10 ms, T_{vj} = 150°C	I_{FSM}		600 470	A A
Grenzlastintegral I²t - value	t_p = 10 ms, T_{vj} = 25°C t_p = 10 ms, T_{vj} = 150°C	I²t		1800 1100	A²s A²s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	T_{vj} = 150°C, I_F = 50 A	V_F		1,00		V
Sperrstrom Reverse current	T_{vj} = 150°C, V_R = 1600 V	I_R		1,00		mA
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode	R_{thJC}			0,650	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,354		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions		$T_{vj\,op}$	-40		150	°C

IGBT, Brems-Chopper / IGBT, Brake-Chopper

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	T_{vj} = 25°C	V_{CES}	650	V
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	T_C = 80°C, $T_{vj\,max}$ = 175°C T_C = 25°C, $T_{vj\,max}$ = 175°C	$I_{C\,nom}$ I_C	50 70	A A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	t_P = 1 ms	I_{CRM}	100	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 25°C I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 125°C I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 150°C	$V_{CE\,sat}$		1,55 1,70 1,75	1,95	V V V
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	I_C = 0,80 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C	V_{GEth}	5,05	5,80	6,45	V
Gateladung Gate charge	V_{GE} = -15 V ... +15 V	Q_G		0,50		µC
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	T_{vj} = 25°C	R_{Gint}		0,0		Ω
Eingangskapazität Input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V	C_{ies}		3,10		nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V	C_{res}		0,095		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 650 V, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C	I_{CES}			1,0	mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25°C	I_{GES}			100	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 8,2 Ω, T_{vj} = 150°C	$t_{d\,on}$		0,023 0,023 0,023		µs µs µs
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 8,2 Ω, T_{vj} = 150°C	t_r		0,015 0,018 0,02		µs µs µs
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 8,2 Ω, T_{vj} = 150°C	$t_{d\,off}$		0,18 0,20 0,205		µs µs µs
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 8,2 Ω, T_{vj} = 150°C	t_f		0,055 0,06 0,06		µs µs µs
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, L_S = 30 nH, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, di/dt = 2800 A/µs (T_{vj} = 150°C), T_{vj} = 125°C R_{Gon} = 8,2 Ω, T_{vj} = 150°C	E_{on}		0,33 0,375 0,475		mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, L_S = 30 nH, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, du/dt = 4200 V/µs (T_{vj} = 150°C), T_{vj} = 125°C R_{Goff} = 8,2 Ω, T_{vj} = 150°C	E_{off}		1,80 2,25 2,40		mJ mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 360 V, t_P ≤ 10 µs, T_{vj} = 25°C V_{CEmax} = V_{CES} -L_{sCE} ·di/dt, t_P ≤ 10 µs, T_{vj} = 150°C	I_{SC}		240 190		A A
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro IGBT / per IGBT	R_{thJC}			0,800	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,436		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions		$T_{vj\,op}$	-40		150	°C

Diode, Brems-Chopper / Diode, Brake-Chopper

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}		650	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_F		20	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	t_P = 1 ms	I_{FRM}		40	A
Grenzlastintegral I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 150°C	I²t		49,0 45,0	A²s A²s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	I_F = 20 A, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C I_F = 20 A, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 125°C I_F = 20 A, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 150°C	V_F		1,60 1,55 1,50	2,00	V V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	I_F = 20 A, - di_F/dt = 1800 A/µs (T_{vj}=150°C), T_{vj} = 25°C V_R = 300 V, T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	I_{RM}		34,0 38,0 40,0		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	I_F = 20 A, - di_F/dt = 1800 A/µs (T_{vj}=150°C), T_{vj} = 25°C V_R = 300 V, T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	Q_r		1,00 1,75 2,20		µC µC µC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	I_F = 20 A, - di_F/dt = 1800 A/µs (T_{vj}=150°C), T_{vj} = 25°C V_R = 300 V, T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{rec}		0,21 0,37 0,47		mJ mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode	R_{thJC}			2,30	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		1,25		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions		$T_{vj\,op}$	-40		150	°C

NTC-Widerstand / NTC-Thermistor

Charakteristische Werte / Characteristic Values

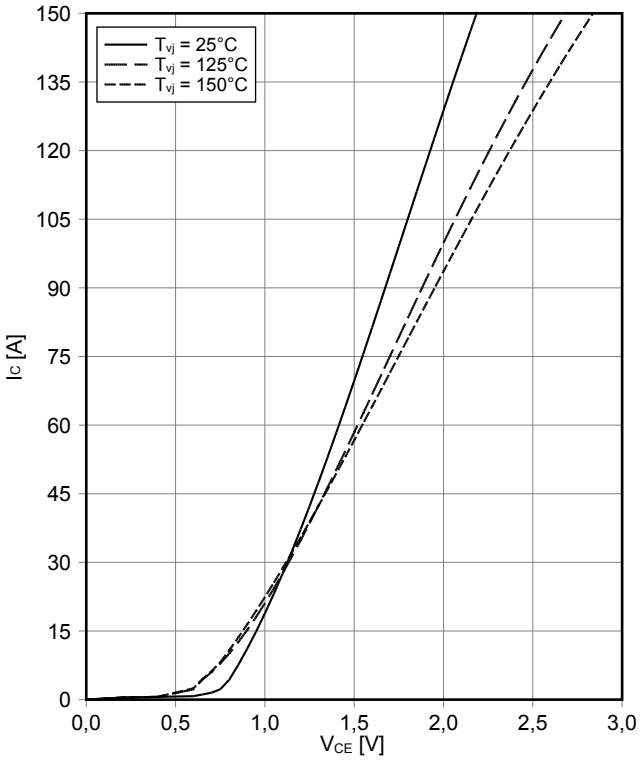
			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand Rated resistance	T_{NTC} = 25°C	R_{25}		5,00		kΩ
Abweichung von R100 Deviation of R100	T_{NTC} = 100°C, R_{100} = 493 Ω	ΔR/R	-5		5	%
Verlustleistung Power dissipation	T_{NTC} = 25°C	P_{25}			20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298{,}15\ K))]$	$B_{25/50}$		3375		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298{,}15\ K))]$	$B_{25/80}$		3411		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298{,}15\ K))]$	$B_{25/100}$		3433		K

Angaben gemäß gültiger Application Note.
Specification according to the valid application note.

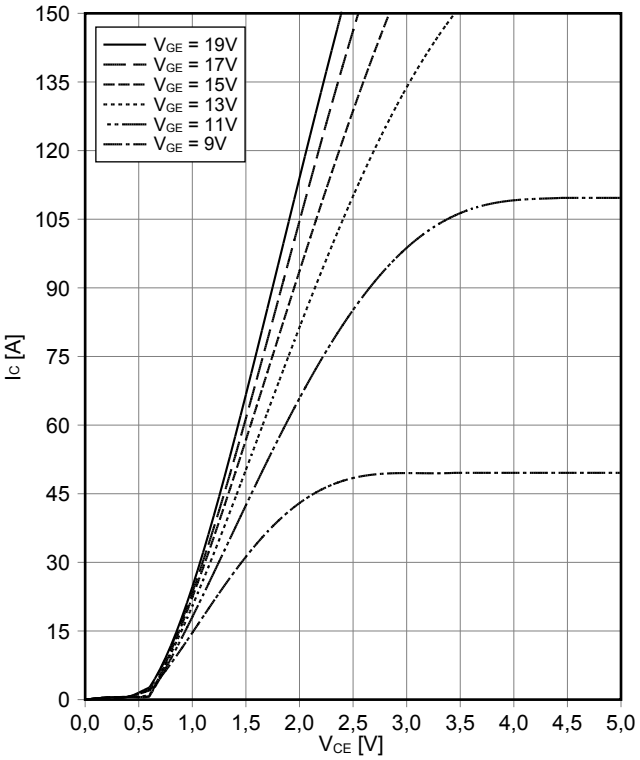
Modul / Module

Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V_{ISOL}		2,5		kV
Material Modulgrundplatte Material of module baseplate				Cu		
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)			Al_2O_3		
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			10,0		mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			7,5		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI		> 200		
			min.	typ.	max.	
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,02		K/W
Modulstreuinduktivität Stray inductance module		L_{sCE}		35		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip	T_C = 25°C, pro Schalter / per switch	$R_{CC'+EE'}$ $R_{AA'+CC'}$		4,00 3,00		mΩ
Lagertemperatur Storage temperature		T_{stg}	-40		125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage Mounting torque for modul mounting	Schraube M5 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M5 - Mounting according to valid application note	M	3,00		6,00	Nm
Gewicht Weight		G		180		g

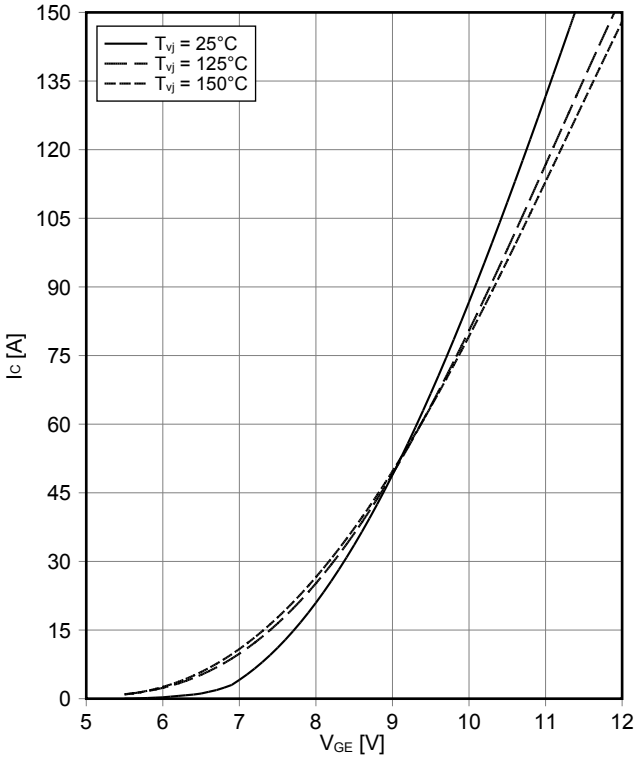
Ausgangskennlinie IGBT,Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V



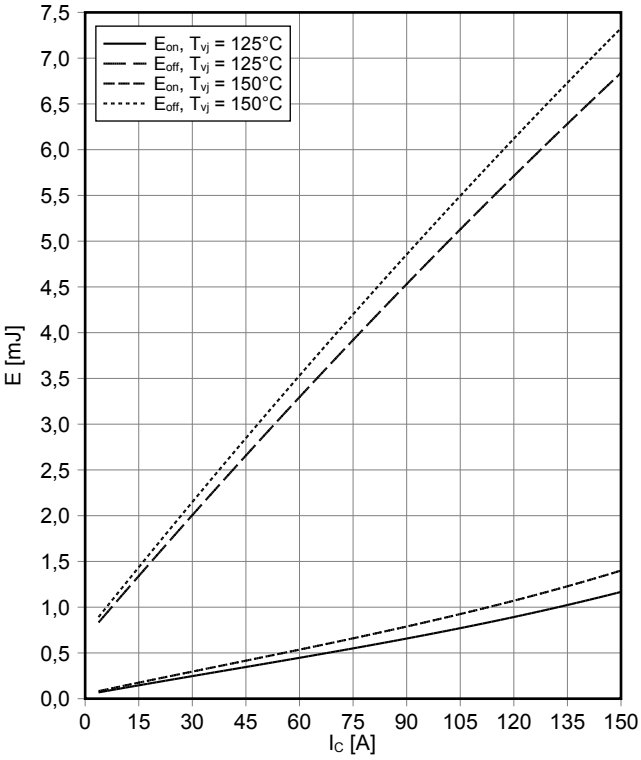
Ausgangskennlinienfeld IGBT,Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
T_{vj} = 150°C



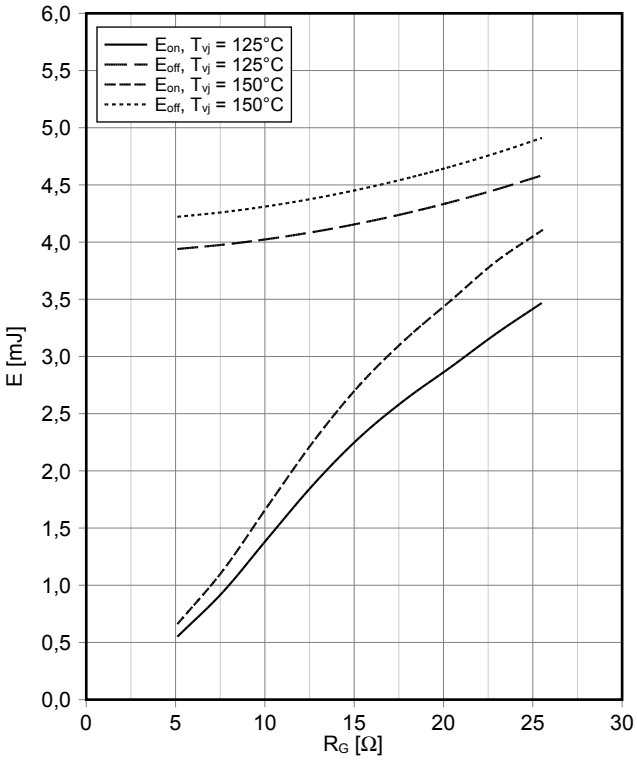
Übertragungscharakteristik IGBT,Wechselrichter (typisch)
transfer characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{GE})$
V_{CE} = 20 V



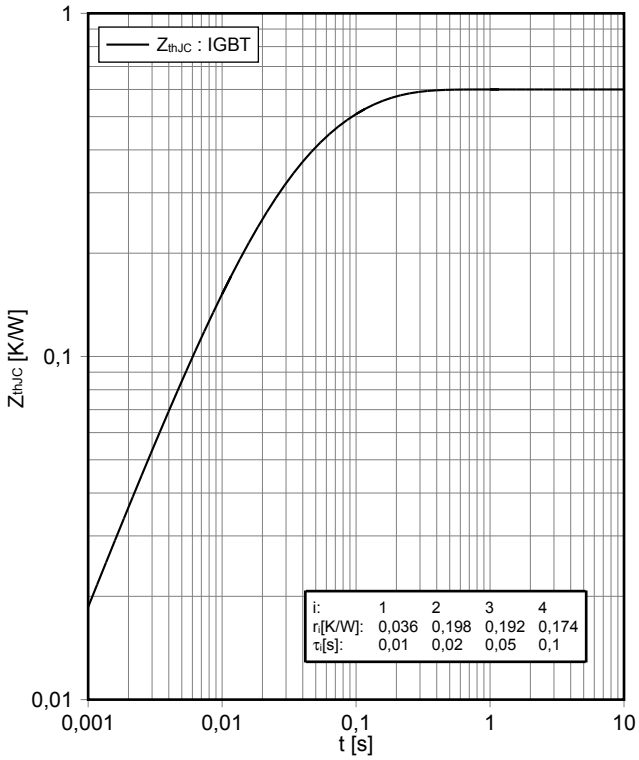
Schaltverluste IGBT,Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT,Inverter (typical)
$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 5.1 Ω, R_{Goff} = 5.1 Ω, V_{CE} = 300 V



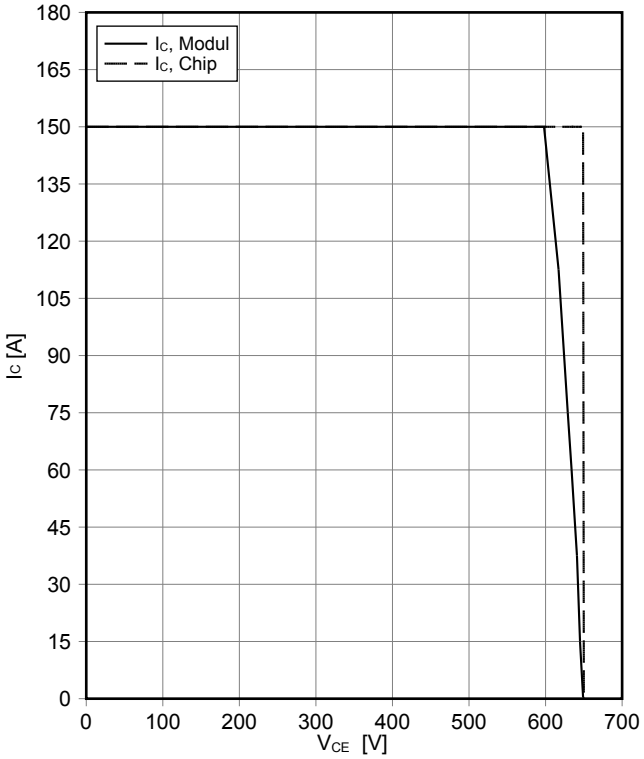
Schaltverluste IGBT,Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT,Inverter (typical)
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
V_{GE} = ±15 V, I_C = 75 A, V_{CE} = 300 V



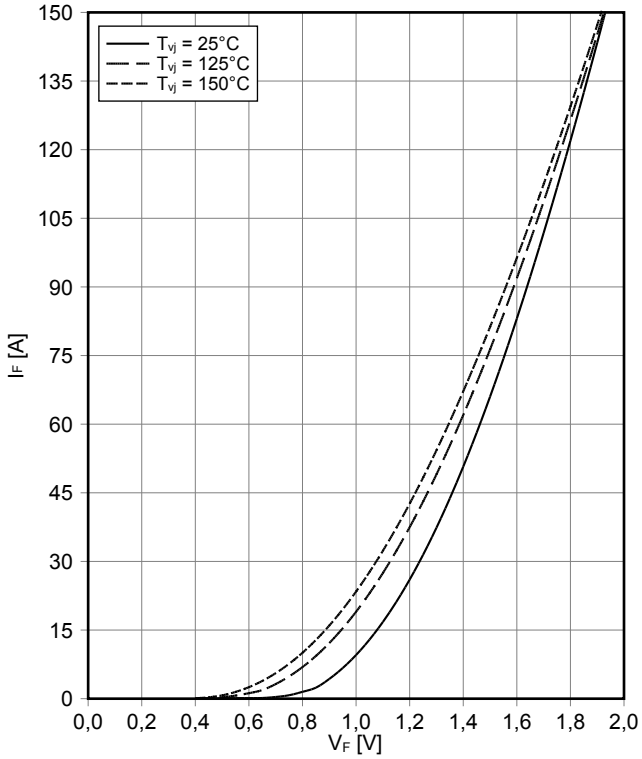
Transienter Wärmewiderstand IGBT,Wechselrichter
transient thermal impedance IGBT,Inverter
$Z_{thJC} = f(t)$



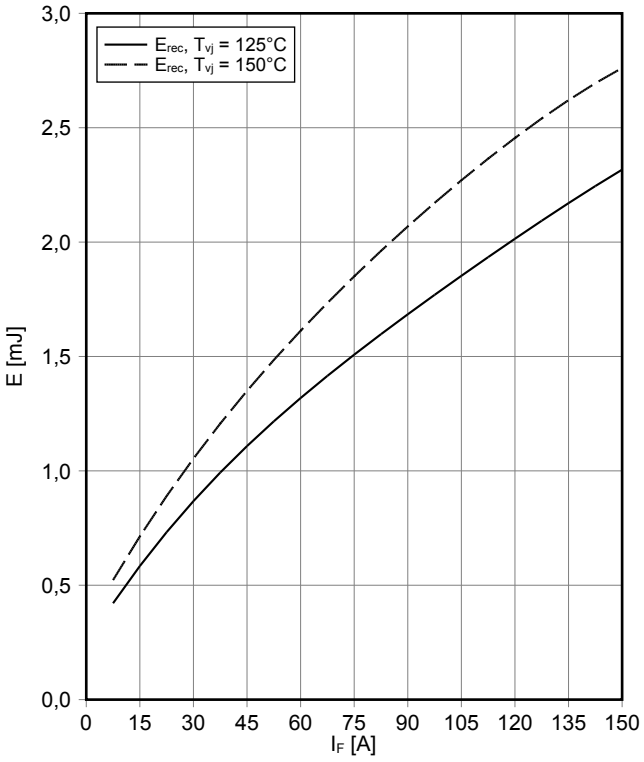
Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT,Wechselrichter (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT,Inverter (RBSOA)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 5.1 Ω, T_{vj} = 150°C



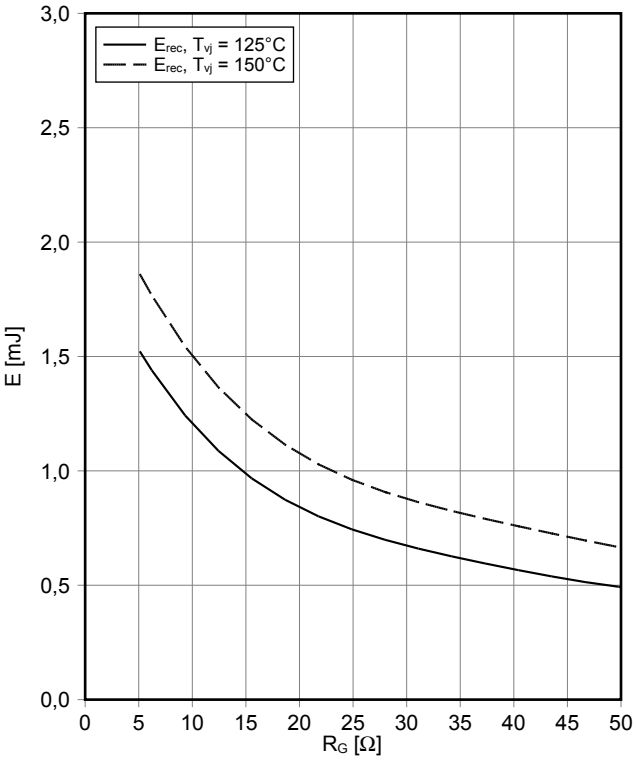
Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)
$I_F = f(V_F)$



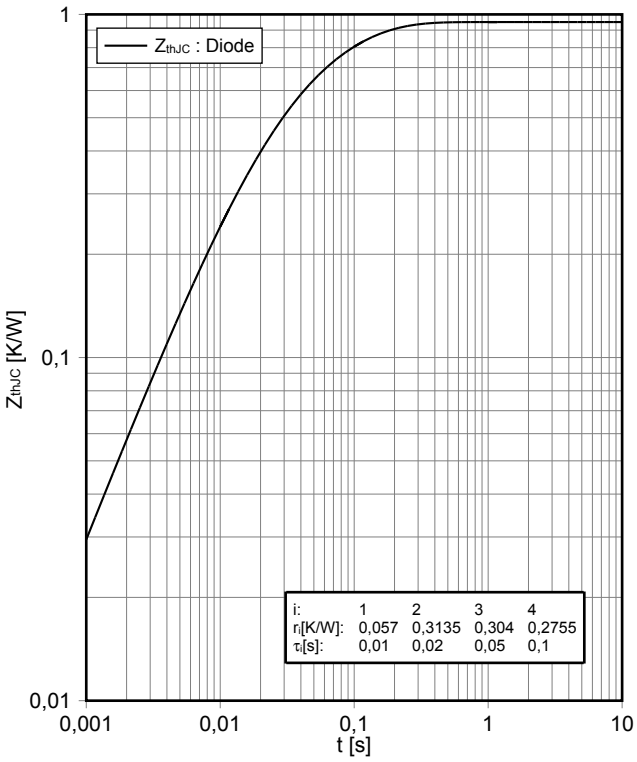
Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
switching losses Diode, Inverter (typical)
$E_{rec} = f(I_F)$
$R_{Gon} = 5.1\ \Omega$, $V_{CE} = 300$ V



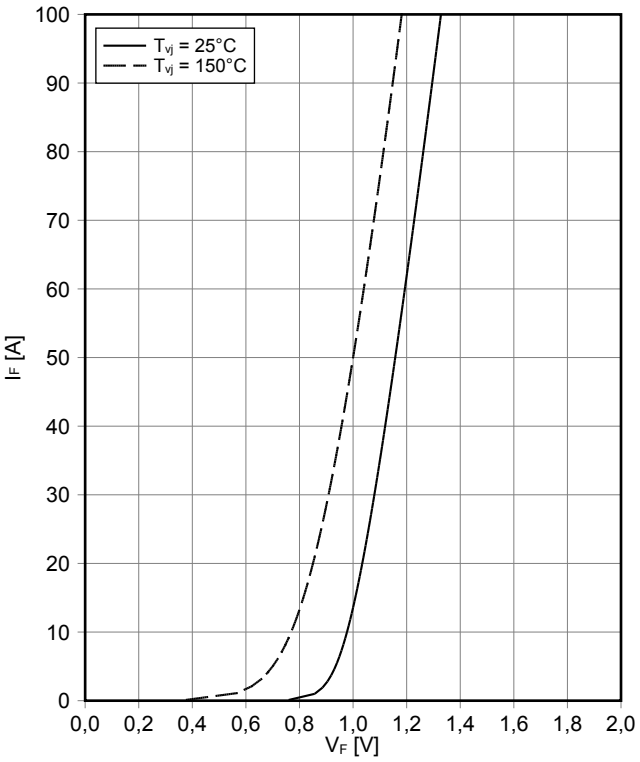
Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
switching losses Diode, Inverter (typical)
$E_{rec} = f(R_G)$
$I_F = 75$ A, $V_{CE} = 300$ V



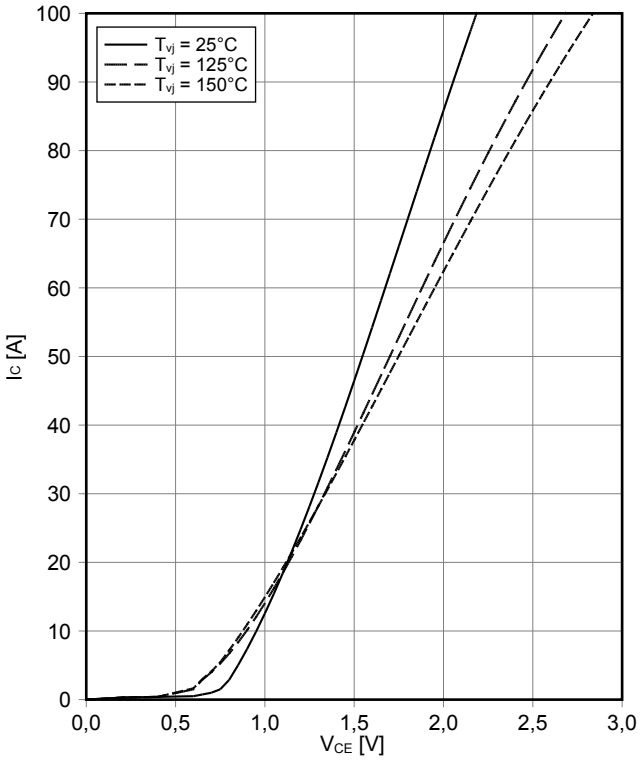
Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter
transient thermal impedance Diode, Inverter
$Z_{thJC} = f(t)$



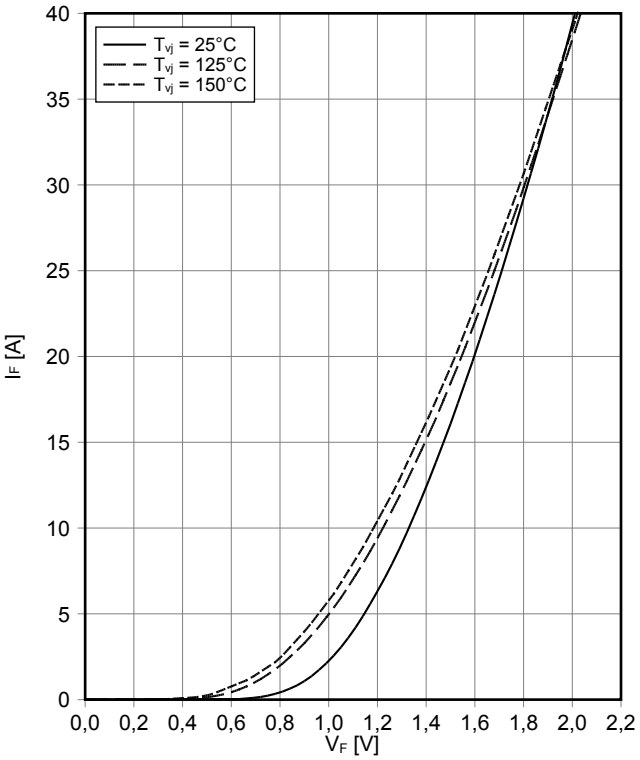
Durchlasskennlinie der Diode, Gleichrichter (typisch)
forward characteristic of Diode, Rectifier (typical)
$I_F = f(V_F)$



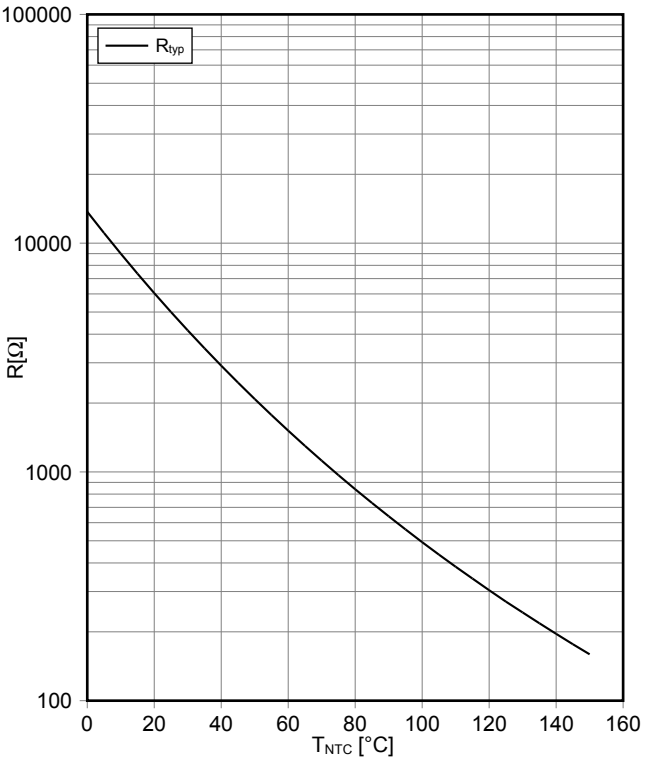
Ausgangskennlinie IGBT, Brems-Chopper (typisch)
output characteristic IGBT, Brake-Chopper (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
$V_{GE} = 15\ V$



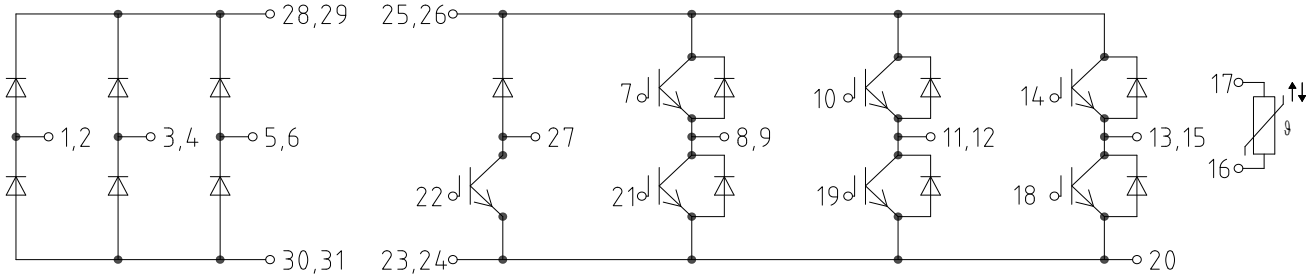
Durchlasskennlinie der Diode, Brems-Chopper (typisch)
forward characteristic of Diode, Brake-Chopper (typical)
$I_F = f(V_F)$



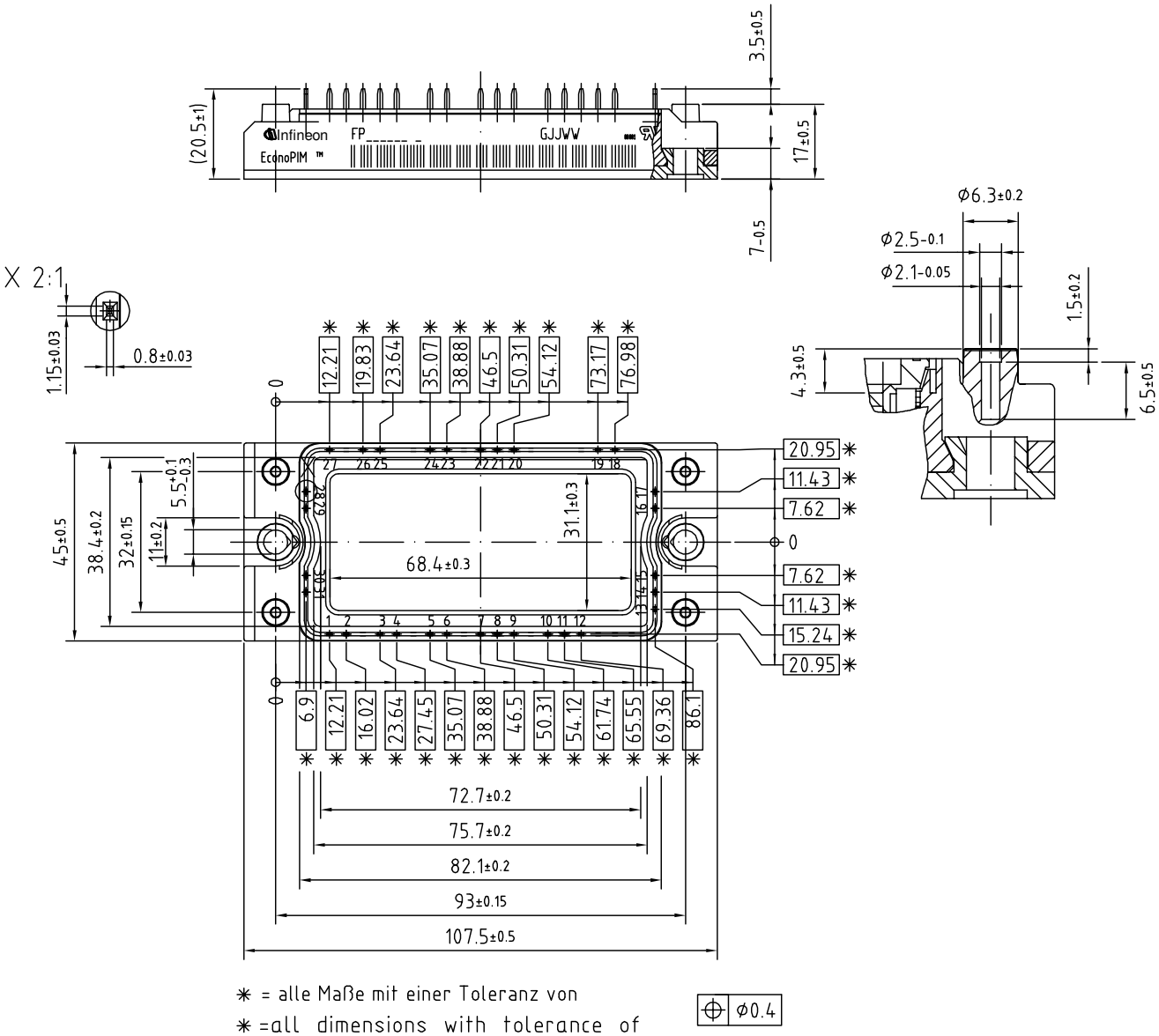
NTC-Widerstand-Temperaturkennlinie (typisch)
NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)
$R = f(T)$



Schaltplan / Circuit diagram



Gehäuseabmessungen / Package outlines



∗ = alle Maße mit einer Toleranz von

∗ =all dimensions with tolerance of

⌖ Φ0.4

Trademarks
All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2017-06-22

Published by
Infineon Technologies AG
81726 München, Germany

Do you have a question about this document?
Email: erratum@infineon.com

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar. Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Sollten Sie von uns weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Produkt, der Technologie, Lieferbedingungen bzw. Preisen benötigen, wenden Sie sich bitte an das nächste Vertriebsbüro von Infineon Technologies (www.infineon.com).

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.

IMPORTANT NOTICE

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office (www.infineon.com).

WARNINGS

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can reasonably be expected to result in personal injury.